受験番号	
氏 名	

令和4年度東京大学大学院理学系研究科 物理学専攻修士課程入学試験問題

専 門 科 目

令和3年8月23日(月) 13時30分~17時30分

【注意事項】

- 1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはならない。
- 2. 解答には、必ず黒色鉛筆(または黒色シャープペンシル)を使用すること。
- 3. 問題は全部で4問ある。4問すべてに解答せよ。
- 4. 答案用紙は各問につき1枚、合計4枚配付されていることを確かめること。
- 5. 問題冊子の所定欄に受験番号、氏名を記入すること。
- 6. 各答案用紙の所定欄に科目名 (専門科目)、受験番号、氏名、問題番号を記入 すること。
- 7. 解答は、各問ごとに別々の答案用紙を使用すること。
- 8. 答案用紙は点線で切り取られるので、裏面を使用する場合には、裏面の点線より上部を使用しないこと。
- 9. 答案用紙には解答に関係ない文字、記号、符号などを記入してはならない。
- 10. 解答できない場合でも、答案用紙に科目名(専門科目)、受験番号、氏名、問題番号を記入して提出すること。
- 11. 答案用紙を計算用紙として使用してはならない。計算用紙は別に配付する。





第1問

量子力学において不確定性関係は重要な役割を果たす。与えられた量子状態に対する, 位置演算子 â と運動量演算子 â の標準偏差を

$$\Delta x \equiv \sqrt{\langle (\Delta \hat{x})^2 \rangle}, \quad \Delta \hat{x} \equiv \hat{x} - \langle \hat{x} \rangle$$
$$\Delta p \equiv \sqrt{\langle (\Delta \hat{p})^2 \rangle}, \quad \Delta \hat{p} \equiv \hat{p} - \langle \hat{p} \rangle$$

と定義しよう。ここで、 $\langle \hat{O} \rangle$ は演算子 \hat{O} の量子力学的期待値である。以下の設問に答えよ。なお、必要があれば次の積分公式を使ってもよい。

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha^3}} \quad (\alpha > 0)$$

また, ħはプランク定数を 2πで割った量とする。

1. 波動関数

$$\psi(x) = \left(\frac{1}{\pi a^2}\right)^{\frac{1}{4}} \exp\left(-\frac{x^2}{2a^2}\right) \quad (a > 0)$$

に対して Δx , Δp を計算し, その結果を物理的に解釈せよ。

2. 一般に、 Δx と Δp の間には不等式

$$\Delta x \Delta p \ge \frac{\hbar}{2} \tag{1}$$

が成立する。これを示すために、まず、任意の演算子 \hat{O} とそのエルミート共役演算子 \hat{O}^\dagger に対して

$$\langle \hat{O}^{\dagger} \hat{O} \rangle \geq 0$$

が成立することを示せ。

- 3. 次に $,\hat{O}=t\Delta\hat{x}-i\Delta\hat{p}$ (t は任意の実数) とおくことで不等式 (1) を示せ。
- 4. 設問 3 の \hat{O} の固有値が 0 を含むための t に関する条件を述べ, 固有値 0 に対応する固有状態が不等式 (1) の等号を満足することを示せ。
- 5. 不等式 (1) の等号が成立する状態を最小不確定状態という。設問 4 の結果を用いて,最小不確定状態を記述する 1 に規格化された波動関数を求めよ。

第2問

体積 $V=L^3$ の相互作用が無視できる理想ボース気体を考える。ボース粒子の質量は m,粒子数は N とする。以下の設問に答えよ。なお,必要であれば,プランク定数を 2π で割った量 \hbar を用いてもよい。

まず、スピンが0のボース粒子を考える。

1. 全ての一粒子固有エネルギーとそれに対応する固有波動関数 $\Psi(x,y,z)$ を求めよ。ただし、 $\Psi(x,y,z)$ は周期境界条件

$$\Psi(x+L,y,z)=\Psi(x,y,z),\ \Psi(x,y+L,z)=\Psi(x,y,z),\ \Psi(x,y,z+L)=\Psi(x,y,z)$$
 を満たすとする。また、基底状態のエネルギーは $E=0$ であるとする。

2. 固有エネルギー E_i をもつ一粒子固有状態 i の大分配関数は,温度 T,化学ポテンシャル μ (μ < 0),ボルツマン定数 k_B を用いて

$$\Xi_i = \sum_{n_i=0}^{\infty} \exp\left[-\frac{(E_i - \mu)n_i}{k_{\rm B}T}\right]$$

で与えられる。このとき、状態 i に存在する粒子数の統計力学的平均値 (ボース分布関数) $f(E_i,\mu)$ を求めよ。導出の過程も示すこと。

以下では、Lが十分大きく、エネルギー準位が連続とみなせるとする。

- 3. エネルギーが 0 から E の範囲にある一粒子固有状態の数を $\Omega(E)$ とすると、状態密度は $D(E)=\frac{d\Omega(E)}{dE}$ で与えられる。 D(E) を求めよ。
- 4. ある温度 $T=T_{\rm c}$ より高温では、設問 2 と 3 の結果を用いて、全粒子数 N は

$$N = \int_0^\infty f(E, \mu) D(E) dE \tag{1}$$

と表される。式 (1) の右辺は、温度一定のもとで、 μ ($\mu \le 0$) の単調増加関数である。 $\mu = 0$ のときの積分を評価せよ。なお、

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{\sqrt{x}}{e^x - 1} dx = \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^{3/2}} = \zeta(\frac{3}{2})$$

を用いてもよい。ここで、 $\zeta(x)$ はリーマンのゼータ関数である。

5. $T < T_c$ では、マクロな数の粒子がエネルギー最低の一粒子状態をとり、全粒子数 N は、エネルギー最低の一粒子状態 (E=0) にある粒子数 N_0 とそれ以外の状態にある粒子数 の和として以下のように表される。

$$N = N_0 + \int_0^\infty f(E, \mu = 0) D(E) dE$$

この現象をボース・アインシュタイン凝縮と呼ぶ。転移温度 Tc を求めよ。

- 6. $T < T_c$ における N_0 を N, T, T_c を用いて表せ。
- 7. $T < T_{\rm c}$ における定積熱容量 $C_V = \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_{N,V}$ は定数 a を用いて $C_V = aT^\gamma$ と表される。 γ の値を求めよ。

次に、ボース粒子がスピン S をもつ場合を考える。

- 8. 外部磁場がない場合の状態密度 D(E) とボース・アインシュタイン凝縮の転移温度 $T_{\rm c}'$ を求めよ。
- 9. 磁束密度の大きさが B の外部磁場を z 方向にかけると,ゼーマンエネルギーによりスピン自由度の縮退が解ける。ゼーマンエネルギーは c をある正の定数として $-cm_zB$ (m_z はスピン磁気量子数 -S, -S+1, \cdots , S) と書けるとする。ボース・アインシュタイン凝縮の転移温度 T_c' を決める方程式を書き下せ。
- 10. 転移温度 $T_{\rm c}'$ の B 依存性の概略を図示し,その $cB\gg k_{\rm B}T_{\rm c}'$ における振る舞いを述べよ。なお, $\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^\infty \sqrt{x}e^{-x}dx=1$ を用いてもよい。

第3問

3次元空間において、z<0の領域から、平面電磁波が入射する場合について考える。入射した電磁波は、z<0の領域とは誘電率が異なる z>0の領域との境界(z=0)において、透過および反射する。電磁波の速さは、z<0でv, z>0で2v であるとし、透磁率は z<0とz>0で等しいとする。Maxwell 方程式は、

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \tag{1}$$

$$\nabla \times \left(\frac{B}{\mu}\right) = \frac{\partial \left(\varepsilon E\right)}{\partial t} \tag{2}$$

$$\nabla \cdot (\varepsilon E) = 0 \tag{3}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0 \tag{4}$$

と書ける。ここで E は電場,B は磁束密度, ε は誘電率, μ は透磁率を表す。また,式 (1) と式 (2) より,境界面において E と B の接線成分が連続であることが導かれる。必要ならば,任意のベクトル V に対して $\nabla \times (\nabla \times V) = \nabla (\nabla \cdot V) - \nabla^2 V$ であることを用いてよい。

はじめに、平面電磁波が境界面に垂直に入射する場合を考える。入射波の電場は、その振幅 E_0 を用いて、 $E_1=(0,E_0\cos{(kz-\omega t)},0)$ と書けるものとする。ここで、k と ω は、いずれも正の定数であり、 $\omega=vk$ である。

- 1. 入射波の磁束密度は、定ベクトル B_0 を用いて、 $B_1 = B_0 \cos(kz \omega t)$ と書ける。式 (1) を満たすような B_0 を, E_0 と v を用いて表せ。
- 2.z>0 における誘電率は、z<0 における誘電率の何倍か。
- 3. 透過波の電場は $E_2 = (0, T\cos(kz/2 \omega t), 0)$,反射波の電場は $E_3 = (0, R\cos(-kz \omega t), 0)$ と書くことができる。ここで, $T \in R$ は, $z \in t$ に依らない定数である。境界面において E および B (または $\partial B/\partial t$) の接線成分が連続であることを用いて, T/E_0 を求めよ。

次に,入射波の電場が $E_1=(0,E_0\cos(qx+2qz-\omega t),0)$ と書ける場合を考える。ここで,q は正の定数である。透過波の電場を,r=(x,y,z) を用いて, $E_2=(0,T\cos(r\cdot Q-\omega t),0)$ と書く。

- 4. Q を q を用いて表せ。
- $5. T の E_0$ に対する比 T/E_0 を求めよ。

最後に,入射波の電場が $E_1=(0,E_0\cos(Kx+Kz-\omega t),0)$ と書ける場合を考える。ここで,K は正の定数である。この場合,電磁波は全反射するが,z>0 の領域にもある程度電磁波が浸透する。

6. z > 0 の領域での電場の振幅を z の関数として書け。

第4問

以下の設問1および2に答えよ。

- 1. f(z) を,実軸上を含む複素上半平面で正則な関数とする。複素上半平面で $|z| \to \infty$ としたとき,f(z) は 0 に収束する。また, x_0 は実数である。
 - (i) 経路 C_- と C_+ を, $z=x_0$ を下半平面及び上半平面に迂回した, $z=-\infty$ から $z=\infty$ までの,実軸上の経路とする(図 1)。以下の積分 I_- と I_+ を求めよ。

$$I_{-} = \int_{C_{-}} dz \frac{f(z)}{z - x_{0}}, \quad I_{+} = \int_{C_{+}} dz \frac{f(z)}{z - x_{0}}$$

ただし、f(z) は C_- 上および C_- の複素上半平面側においても正則とする。解答は $f(x_0)$ を用いて表してよい。

(ii) θ_n (n=1, 2) を $0 < \theta_n < \pi$ を満たす実数,また, $z_n = x_0 + ae^{i\theta_n}$ (a は正の実数) とする。 C_{12} を, z_1 を始点とし z_1 と z_2 をつなぐ線分で与えられる経路とする(図 1)。以下の量を θ_1 , θ_2 , $f(x_0)$ を用いて表せ。

$$\lim_{a \to +0} \int_{C_{12}} dz \frac{f(z)}{z - x_0}$$

(iii) A をある定数として以下の関係式が成り立つことを示すとともに、定数 A を求めよ。

$$\operatorname{Re} f(x_0) = A \lim_{\epsilon \to +0} \left[\int_{-\infty}^{x_0 - \epsilon} dx \frac{\operatorname{Im} f(x)}{x - x_0} + \int_{x_0 + \epsilon}^{\infty} dx \frac{\operatorname{Im} f(x)}{x - x_0} \right]$$

ただし上式で、x に関する積分は実軸上の積分である。また、 $\operatorname{Re} f(z)$ と $\operatorname{Im} f(z)$ は それぞれ関数 f(z) の実部と虚部を表す。

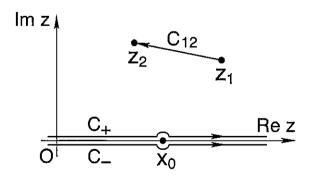


図 1: 積分経路。ただし、経路 C_- と C_+ は実軸上からずらして表示している。

2. n を $n \ge 2$ の自然数として,I を n 次元単位行列, \vec{v} を n 次元実単位ベクトルとする $(\vec{v}^T\vec{v}=1$,ただし \vec{v}^T は \vec{v} の転置ベクトル)。そして, $n\times n$ 実行列 C を以下のように与える。

$$C = pI - q\vec{v}\vec{v}^T$$

ただしpとqは正の実数である。

- (i) \vec{v} は C の固有ベクトルである。対応する固有値を求めよ。
- (ii) \vec{w} を \vec{v} と直交するベクトルとすると、 \vec{w} は C の固有ベクトルである。対応する固有値を求めよ。
- (iii) 行列式 det C を求めよ。

次に, $A \in n \times n$ の実対称行列とし,

$$B = CA$$

とする。Aの固有値は0を含まない。行列Bは、 $q=q_0$ で $\det B=0$ となるとする。

- (iv) q_0 を p を用いて表せ。
- (v) 行列 B が実行列であることに注意して、 β が B の固有値であればその複素共役 β^* も B の固有値であることを示せ。

さらに、n次元実ベクトル d(t) は以下の微分方程式に従うとする。

$$\frac{d}{dt}\vec{g} = -B\vec{g} \tag{1}$$

- (vi) A の固有値が全て正の場合を考える。 $q>q_0$ のとき、任意のn 次元実単位ベクトル \vec{v} に対して $\lim_{t\to\infty}||\vec{g}(t)||=\infty$ となるような微分方程式 (1) の解が存在することを示せ。ただし、 $||\vec{g}||\equiv\sqrt{\vec{g}^T\vec{g}}$ である。
- (vii) A が一つだけ負の固有値を持つ場合を考える。 $q>q_0$ のとき、 \vec{v} をうまく選ぶと微分方程式 (1) の任意の解が $\lim_{t\to\infty}||\vec{g}(t)||=0$ となる。このような \vec{v} が存在することを示せ。